Accounts of Materials & Surface Research

Discovery of yellow nitride phosphor for white LED

Takatoshi Seto

Advanced Technologies Research Institute, Denka Corporation (present) 3-5-1 Asahi-machi, Machida, Tokyo, 194-8560, Japan takatoshi-seto@denka.co.jp

A combination of blue LED and phosphors having longer wavelength of excitation can be a candidate for LED device lighting or display. Breakthrough occurred in the field of not only LED but also phosphors about two decades ago, then nitride phosphors appeared for the first time. Created several nitrides have been actually used in LED business and industry. Here, I describe the process of our discovery of new phosphor, blue-excited yellow $La_3Si_6N_{11}$:Ce

LSN has a significantly longer (LSN). wavelength of excitation than a similar nitride, LaSi₃N₅:Ce, has. In this article, the reason of significant difference in wavelength of excitation between LSN and LaSi₃N₅:Ce was studied by use of Dorenbos theory concerning polarizability and coordination distance in phosphors. The study indicates that the calculated difference in energy level between 5d orbitals centroid and 4f orbital at one of the two Ce sites in LSN is much shorter than that at another Ce site in LSN and that at Ce site in LaSi₃N₅:Ce, roughly coinciding with the centroid of the long wavelength of excitation in LSN. Not only high polarizability and shorter coordination distance but also Ce local structure of symmetric eight coordination is suggested as the reason of longer wavelength of excitation.



Keyword: Nitride phosphor, LED, Wavelength of excitation, Polarizability, Coordination distance

Takatoshi Seto received BSc, MSc, and DSc from the University of Tokyo in 1980, 1982, and 1997, respectively. He was a selected student for studying at the University of Cambridge, receiving Certificate of Postgraduate Study from the Faculty of Physics and Chemistry in 1991. He was an independent researcher at % tructure and functional property+; PRESTO, JST from 1993 to 1996. At Mitsubishi Chemical Corporation he had researched LED phosphor as chief researcher and then team leader, and retired in 2012. He was invited to do and



organize the research of phosphor as project leader and principal researcher at Samsung R&D Institute Japan. Now, he is currently the research advisor at Advanced Technologies Research Institute, Denka Corporation since 2015.

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.2), 49-56.

白色 LED 用黄色窒化物蛍光体の発見

瀬戸孝俊 *アドバイザー*

1. LED 用蛍光体の経緯

発光効率に優れた青色 LED が中村らによ り見出されて以来[1]、ここ20年で、青 LED 又 は近紫外 LED と蛍光体を組み合わせて照明 やディスプレイをつくる試みと研究開発がなさ れてきた。それ以前に良く研究され、実用化さ れていた蛍光体は、珪酸塩、リン酸塩、アルミ ン酸塩等の酸化物、硫化物、ハロゲン酸塩等 であった。その多くは、青 LED の発光波長 450nm 付近で励起されず、短波長励起である ため、青 LED との組み合わせにマッチしなか ったし、励起波長がマッチしていても、LED 照 明用等に要求される使用時の寿命が十分で ないものが多かった。現在、青 LED 用として 主役を担っている賦活元素は、第一に Eu²⁺、 第二に Ce³⁺、第三に Mn⁴⁺といえよう。青 LED 用では、蛍光灯等の水銀輝線 254nm やプラ ズマディスプレイ等の147nm 又は172nmという 短波長の励起源の場合によくみられる母体励 起、そして、賦活元素にそのエネルギーが流 れるメカニズムが主流ではなく、青光が母体 中の賦活元素に直接吸収される直接吸収が 主流となる。そして、Eu²⁺や Ce³⁺では、励起は、 4f→5d軌道の遷移過程が、発光は、5d→4f 軌道の遷移過程が担っている。Eu²⁺や Ce³⁺の 5d軌道は、近傍のアニオン配位子により結晶 場分裂(錯体の分野での3d軌道の配位子場 分裂と同様)を受け、また、アニオンからの Eu²⁺ や Ce³⁺への電子の流れやすさを表す Nephelauxetic 効果を受けるため、それぞれ、 5d軌道の分裂幅増大、及び、5d軌道の重心 のエネルギーレベルの低下がおこり、近傍ア ニオンによってほとんど変化を受けない4f軌 道レベルと5d軌道とのエネルギー差が縮まる ため、4f→5dにおける励起帯が長波長化する

し、5dの最低レベル→4f軌道における発光が 長波長化する。

青 LED 用に、従来の酸素アニオン配位子 よりも励起・発光を長波長化できそうなものは、 窒素アニオンと考えることは自然なことであっ たろう。しかし、本当に窒化物の母体が実用 的な蛍光体にまでたどりつくには、長波長励 起以外の数々の乗り越える特性上の関門があ ったはずである。第一に、概して、酸化物より 窒化物の方がバンドギャップが少々狭くなる 傾向があったので、発光が十分とならなかっ たかもしれないこと、第二に、配位座標モデル にて励起曲線と発光曲線の交差点から励起 エネルギーがすり抜ける割合が多かったかも しれないこと、第3に、発光を阻害する窒化物 に特有な致命的欠陥が発生したかもしれない こと、第四に、長時間の使用に耐えられない 窒化物に特有の致命的な欠陥があったかもし れない。2000年頃に初めて登場した、結晶構 造学的に 100%窒化物である Eu²⁺賦活蛍光体 は、そのような初物の持つ懸念(上記第一,二, 三)をほとんど払拭するようなものであった[2]。 その後、すぐに、日本、ドイツ、オランダを中心 に新規窒化物蛍光体創出競争がおこり[3-6]、 今に至っている。なお、数少ない安定で、青 光励起という長波長励起が可能な黄色 (Y,Gd)₃Al₅O₁₂:Ce(YAGと呼称)と青 LEDとを組 み合わせた LED 照明の開発は、窒化物蛍光 体の登場より早く、青 LED を発明した日亜化 学が実施した。多くの窒化物、酸窒化物、酸 化物の蛍光体が研究されてきたが、実際には 限られた数の蛍光体のみが LED 用に使われ ているのが現状である。次に、第2節にて、筆 者らが発見した青励起黄色窒化物蛍光体 La₃Si₆N₁₁:Ce(LSN と呼称)を紹介し[4]、発見

Prepared La/Si	Composition	Normalized	emission intensity	Crystal ph	ase on XRD
molar ratio	on preparation	Blue	Yellow	LaSi ₃ N₅	La ₃ Si ₆ N ₁₁
0.5	$La_3Si_6N_{11}$	0.71	0	_	_
0.56	La _{3.36} Si ₆ N _{11.36}	0.39	0.83	0.13	0.45
0.62	La _{3.72} Si ₆ N _{11.72}	0	1.0	0	0.68
0.66	$La_4Si_6N_{12}$	0	0.62	0	1

Table 1. Effect of prepared La/Si ratio on the formation of La₃Si₆N₁₁ phase and LaSi₃N₅ phase

に至ったプロセスを解説し、第3節にて、LSN が青 LED 用にマッチした長波長励起帯を有 する原因を解明すべく、著者が粗計算をした 結果を報告し、解説を加える。

2. 青 LED 用窒化物蛍光体 La₃Si₆N₁₁:Ce (LSN)の発見

Ce 賦活の希土類元素—Si-N の多元系の 窒化物探索をしていたときに、微弱であるが、 青ランプ照射により、黄色に発光する粉の存 在に気付いた。後に確定した組成は、 La₃Si₆N₁₁:Ce であるが、当時は、La:Si 仕込み 比が 3:6 では発光せず、4:6 で黄色に光って いた。こういった点が、組成比を変えたランダ ムな探索法の優位な点の一つといえる。[4]に 掲載されている図の要点を表1として示す。

一方で、オスラムからは、La₃Si₆N₁₁:Ce が青色 に発光する蛍光体であるとする特許出願がな されていた[7]。仕込み組成でみるならば、筆 者らの表1の一行目と合致している。我々は、 新規結晶構造の発見も視野に入れて元素比 をふらした探索研究をしていたので、オスラム の結果にとらわれることはなかった。La/Si 仕 込み比が3から 3.36 に少し増えただけで、青 色発光に混じって黄色発光が見えるようにな った。無機蛍光体は、主に結晶成分が発光す るので、発光物質特定には X 線回折パターン が重要であるが、複数の発光があり、微弱な 発光の場合、発光起源のX線回折パターンを 特定することは難しい。この段階では、仕込み 組成に近い La₅Si₉N₁₇ 新規相を考えることも可 能であったが、結晶相は、主に LaSi₃N₅相と

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.2), 49-56.

La₃Si₆N₁₁ 相からなっているようにみえた。更に La/Si 比を増やしたところ、青色発光が消失し、 黄色発光のみとなった。X 線回折パターンか ら LaSi₃N₅相が消失し、La₃Si₆N₁₁相が増大した。 この時点で、黄色発光物質は、La₃Si₆N₁₁相ら いしいことが強く推定された。LaSi₃N₅:Ce は青 色に発光することが報告されていた。図1に、 典型的な La₃Si₆N₁₁:Ce の励起・発光スペクトル を示す。では、なぜ、La₃Si₆N₁₁:Ce 仕込みで La₃Si₆N₁₁:Ce が生成しなかったのだろうか。以 下にそれについて述べる。





表1は、CeO₂を使用した実験結果である。 窒化物を母体とした蛍光体の実験の場合でも、 Eu²⁺や Ce³⁺といった賦活元素の原料は、微量 しか導入しないため、Eu₂O₃やCeO₂が一般的 であった。La₃Si₆N₁₁:Ce 以前に発見された青 励起赤色蛍光体 CaAlSiN₃:Eu は、Eu₂O₃使用 の場合とEuN 使用の場合とで輝度に大きな違 いが認められなかった。しかしながら、

Molar ratio of Ce	Relative intensity in case of CeN		Relative intensity in case of CeO ₂	
	Blue emission	Yellow emission	Blue emission	Yellow emission
0.015	0	0.41	0	1
0.03	0	0.48	0.15	0.74
0.055	0	0.67	0.32	0.42
0.1	0	1	-	-
0.15	0	0.85	0.5	0
0.3	0.05	0.57	0.47	0
0.6	-	-	1	0

Table 2. Comparison of CeN and CeO₂ starting materials

La₃Si₆N₁₁:Ce の場合は、CaAlSiN₃:Eu とはその 挙動が大きく異なった。

表2に、CeN を使用した場合の黄色発光と 青色発光の挙動、及び、CeO,を使用した場 合のそれらの挙動を示す[4]。CeN の場合、 Ce0.15 モルまでは黄色発光のみで青色光は 全く発生せず、Ce0.3 モルとなってようやく青 色光が微弱に発生しはじめた。それに対し、 CeO2の場合、Ce 濃度が小さな 0.015 モルで は黄色発光のみであったが、Ce0.15 モルで はすでに青色光のみで、黄色光が全く発生し なかった。更には、CeNやCeO2によるX線回 折パターン上の LaSi₃N₅相と La₃Si₆N₁₁相の挙 動が、表2の青色発光と黄色発光の挙動とほ ぼ一致した。表2の CeO2の場合に、黄色発光 がわずか Ce0.015 モル付近で減少しはじめる のは、Ce の濃度消光によるものでなく、CeO。 の中の酸素の増大のためと結論した。合成後 の蛍光体中の酸素の元素分析をしたところ、 蛍光体中の酸素濃度が CeO₂や CeN 中の酸 素量に相関することがわかり、本結論が支持 された。

LED デバイスにおいては、作動中に、LED チップからの発熱や蛍光体からの発熱により、 温度が上昇するため、100-150℃の温度領域 での発光強度の減少が重要視された。近年で は、LED チップのパワーアップに伴い、150℃ 以上の温度領域も問題にすることがある。この ような温度消光の程度をLa₃Si₆N₁₁: Ce につい て測定したところ、従来型の(Y,Gd)₃Al₅O₁₂:Ce (YAG と称する)よりも良好であることが判明した。また、実際の LED デバイスに組み込んでの長時間の高温・高湿下の作動試験も良好であった。

3. LSN が長波長励起可能な理由

この LSN の長波長励起の解釈の前に、そ れ以前に発見されていた紫外励起青色蛍光 体 LaSi₃N₅:Ce とLSN とを結晶構造の上から比 較してみる。図2と図3に、それぞれの母体の 結晶構造イメージを示す。斜方晶、空間群 P2₁2₁2₁の LaSi₃N₅では、SiN₄ 四面体が頂点共 有と稜共有の両方で連なり、Ce が置換しうる La サイトが7個のNの配位を受けており(本解 説にては、3.1Åを超える距離のものを、実質 的に配位していないとして除外)、そのうち6個 のNがそれぞれ2個の Si に配位し、1個の N が3個の Si に配位している。正方晶、空間群 P4bm の La₃Si₆N₁₁は、c軸方向に重なるような 層状構造をなしており、SiN4 四面体が全て頂 点共有となっており、Ce が置換しうるLaサイト が2種類あり、La1サイトがLa2サイトの2倍量 存在し、両サイトとも8個のNの配位を受けて おり、La1サイトでは7個のNがそれぞれ2個の Siに、1個のNが3個のSiに配位しており、La。 サイトでは、8個のN全てがそれぞれ2個のSi に配位しており、配位対称性はLa。サイトの方 がより高い。

Acc. Mater. Surf. Res.

この結晶構造上の配位距離と分極率から5 d軌道のエネルギーレベル低下を粗く予測する粗理論が提出されている。Nephelauxetic 効果ともいえる5d軌道の重心の低下が定量 できれば、励起波長の平均波長が予測できる ことになる。次に、粗理論を紹介する。



Figure 2. Structural image of LaSi₃N₅



Figure 3. Structural image of La₃Si₆N₁₁

MorrisonとAullらが、Ce³⁺等の5d軌道の重 心のエネルギーレベルが、配位するアニオン の分極率と配位距離によって関係づけられる ことを示し[8][9]、Dorenbos により強調された [10]。

$$\begin{split} \epsilon_{c} &= (e^{2}/4\pi \epsilon_{0})(\langle r^{2} \rangle_{5d} - \langle r^{2} \rangle_{4f}) \Sigma_{i=1}^{N} \alpha_{i}/R_{i}^{'6}(1) \\ \epsilon_{c} 5d 分裂軌道の重心のエネルギー低下 \end{split}$$

- (自由イオンのレベルからのシフト分)
 - e 電子の電荷
 - ε 0 真空での誘電率
 - <r²> 電子の位置 r の二乗の期待値
 - α_i 配位子iの分極率
 - R[']_i 配位子 i と Ce³⁺との距離

 Ce^{3+} が置換することによる格子緩和の影響 を考慮して、母体の結晶構造データから得ら れる、 Ce^{3+} が置換する前の母体中カチオンの イオン半径と Ce^{3+} のイオン半径の差 ΔR の約 半分を R_i の計算に適用し、 Ce^{3+} における $\langle r^2 \rangle_{5d}$ と $\langle r^2 \rangle_{4f}$ を計算することにより、次式を 得た[10],[11]。

$$\varepsilon_{\rm c} = 1.79 \times 10^{13} \sum_{\rm i=1}^{\rm N} \alpha_{\rm i} / (R_{\rm i} - 0.6 \Delta R)^6$$
 (2)

R_i Ce³⁺が置換する母体中カチオンと配位
子との距離(母体の結晶構造データベースからの情報)

Dorenbos は、更に、この Ce³⁺に配位する各 アニオンの分極率を蛍光体の母体のアニオン の分極率 α_{sp}と同等であるとしている。

$$\alpha_{i} \approx \alpha_{sp}$$
 (3)

この式の妥当性は、筆者が確信できている ものではないが、16種のフッ化物蛍光体と30 種の酸化物蛍光体の実際の励起スペクトルに 対して、(2)式及び(3)式の使用により辻褄の合 う計算値が得られている。

化合物のアニオン分極率 α_{sp} と化合物中の カチオンの平均電気陰性度 χ_{av} の間には次 の相関が得られている。

$$\alpha_{\rm sp}({\rm O})=0.33 + 4.8/\chi_{\rm av}^2$$
 (4)

$$\alpha_{\rm sp}({\rm F})=0.15+0.96/\chi_{\rm av}^2$$
 (5)

近年、窒化物においても関係式が得られた [12]。

 $\alpha_{\rm sp}(N)=0.87+18.76/\chi_{\rm av}^{-2}$ (6)

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.2), 49-56.

 $\alpha_{sp}(O), \alpha_{sp}(F), \alpha_{sp}(N)は、それぞれ、酸化物母体、フッ化物母体、窒化物母体の<math>\alpha_{sp}$ である。

Table 3. Calculated centroid	shift Ec in LaSi3N5:Ce
------------------------------	------------------------

Distance R _i	Contribution to $\mathbf{\epsilon}_{c}^{*}$ (cm ⁻¹)
of each La-N (Å)	$=1.79 \times 10^{13} \text{ N/}(\text{R}_{i}-0.6 \text{ R})^{6}$
2.571	3685
2.485	4526
2.922	1701
2.591	3516
2.578	3625
2.888	1826
2.943	1629
3	_c (sum) 2.05×10 ⁴ cm ⁻¹
Excitation ce	ntroid 3.07×10 ⁴ cm ⁻¹ (326nm)
* R: 0.018 Å . Pola	rizability ^N : 7.066

Table 4. Calculated $\boldsymbol{\epsilon}_c$ in La₁ of LSN

Distance R _i	Contribution to $\mathbf{\epsilon}_{c}^{*}(cm^{-1})$	
of each La-N (Å)	$=1.79 \times 10^{13} \text{ N/(R_i-0.6 R)^6}$	
2.551	4024	
2.853	2051	
2.623	3406	
2.853	2051	
2.853	2051	
2.674	3031	
2.863	2009	
2.674	3031	
ε	_c (sum) 2.17×10 ⁴ cm⁻¹	
Excitation centroid 2.96×10^4 cm ⁻¹ (338nm)		
[*] R: 0.010 Å . Polarizability ^N : 7.503		
そこで、これらの粗理論を使って、LSN と		

そこで、これらの粗理論を使って、LSN と LaSi₃N₅:Ce の5d分裂軌道の重心のエネルギ ーレベルが自由イオンレベルから下方にシフ トしている分を表す ϵ_{o} 、次に、4f→5d遷移の 励起帯の重心の波長を概算することにより、 実際の励起ピークの波長と比較することがで

Table 5. Calculated $\boldsymbol{\varepsilon}_{c}$	in La ₂ of LSN
---	---------------------------

Distance R _i	Contribution to $\mathbf{\epsilon}_{c}^{*}(cm^{-1})$
of each La-N (Å)	$=1.79 \times 10^{13}$ N/(R _i -0.6 R) ⁶
2.650	3200
2.644	3244
2.650	3200
2.644	3244
2.650	3200
2.644	3244
2.650	3200
2.644	3244
	$\mathbf{\epsilon}_{c}$ (sum) 2.58×10 ⁴ cm ⁻¹
Excitation centre	bid 2.54×10 ⁴ cm ⁻¹ (393nm)
* R: 0.010 Å . Pola	arizability ^N : 7.503

きる。表3,4,及び5には、それぞれ、それらの計算値が示されている。なお、 ϵ 。については、Jia らが最近計算しており[13]、彼らによる計算値 21380 cm⁻¹,23671 cm⁻¹,25166 cm⁻¹に対して、著者による計算値が 2.05×10⁴ cm⁻¹,2.17×10⁴ cm⁻¹,2.58×10⁴ cm⁻¹となり、その傾向が概ね一致した。

励起スペクトルにおける各励起帯は、Ce³⁺ の4f軌道の二本の軌道²F_{5/2}と²F_{7/2}のうち常に 1つの同じ軌道から5dの各分裂軌道に励起さ れて得られるので、両者のエネルギー差が各 励起帯の波長に相当する。4f軌道のエネル ギーレベルはわかっているので、上記 ε の値 から、それぞれ、励起帯の平均位置が、3.07 $\times 10^4$ cm⁻¹ (LaSi₃N₅:Ce), 2.96 $\times 10^4$ cm⁻¹ (LSN の La₁ サイトの Ce³⁺の場合)、2.54×10⁴ cm⁻¹ (LSN の La₂ サイトの Ce³⁺の場合)と計算された。一方、実際の励起スペクトルから、 La_{0.9}Ce_{0.1}Si₃N₅の励起帯の位置が 3.85×10⁴ cm^{-1} (260 nm), $3.55 \times 10^4 cm^{-1}$ (282 nm), 3.19 $\times 10^4$ cm⁻¹ (313 nm), 3.01×10^4 cm⁻¹ (332 nm), 2.82×10⁴ cm⁻¹ (354 nm)と判明しているので [14]、励起帯のエネルギー基準の平均位置は 3.29×10⁴ cm⁻¹ (304 nm)となる。図1において、 La29Ce01Si6N11の励起帯の位置があまり明確 でないが、 3.18×10^4 cm⁻¹ (314 nm), 2.89×10^4

 cm^{-1} (346 nm), 2.65×10⁴ cm⁻¹ (377 nm), 2.18 ×10⁴ cm⁻¹ (459 nm)であり、その場合、5d分裂 軌道のうち2本が縮退していることになる。あら ゆる1組の縮退を想定すると、励起帯の平均 位置が 2.62×10⁴~2.82×10⁴ cm⁻¹ (355~382 nm)領域にあるとわかる。(実測値,計算値)が、 $La_{0.9}Ce_{0.1}Si_{3}N_{5} \rightarrow (3.29 \times 10^{4} \text{ cm}^{-1}, 3.07 \times 10^{4})$ cm⁻¹), La_{2.9}Ce_{0.1}Si₆N₁₁ \rightarrow (2.62×10⁴ \sim 2.82× 10⁴ cm⁻¹, 2.96×10⁴ cm⁻¹(Ce₁の場合)/2.54× 10⁴ cm⁻¹(Ce₂ の場合))となった。主に平均分 極率と賦活元素への配位距離のみをたよりと する Dorenbos 式計算は大きな誤差を含むが、 この計算結果から、なぜ、みかけ上類似する LaSi₃N₅:Ce が短波長励起で、青 LED 用となら ず、LSN が長波長励起で青 LED 用となりえて いるかを読み取ることができる。LSN,Ce2 サイト の配位距離が LaSi₃N₅ 系や LSN, Ce₁ サイトの 値より少し短く、LSN の La/Si 比が LaSi₃N₅系よ り少し大きく、LSN のアニオン分極率が少し大 きいため、励起波長が長くなっていると考えら れた。Ce,サイトが LSN の青色励起・黄色発光 を主に形づくっていると解釈された。発光がお こるためには、4f軌道のエネルギーレベルが 価電子帯より上にあり、5d軌道のエネルギー レベルが伝導帯より下にある必要がある。この 伝導帯と価電子帯の差であるところのバンドギ ャップを Jia らが計算したところによると[14]、 La₃Si₆N₁₁のバンドギャップが、LaSi₃N₅のそれよ り狭く、4f軌道と5d軌道のエネルギー差が大 きな Ce₁ サイトが発光に寄与していないことを 示唆した。このことは、LSN の長波長励起は Ce,サイトによるものとの著者による強い推論と 矛盾のないものとなっている。

励起の長波長化には、結晶場分裂の増大 の寄与もある。LSN の Ce₂サイトは、C₄の配位 対称性の8配位構造となっている。これは、4 配位 N に、ぶつからないように角度を変えて2 組目の4配位が付け加わったものと考えると、 4配位による結晶場分裂の2倍近くの大きな結 晶場分裂が得られていると解釈でき、配位対 称性の良い8配位構造が長波長励起に有利 であると考えられる。

4. おわりに

蛍光体においては、対象が結晶であるだけ に、成立しうる元素組成比はあらゆる比率でな く、とびとびの比率のみとなるため、新規蛍光 体の創出に難しさが伴う。望む特定の励起波 長や発光波長を厳密に設計することも困難で あるが、多数の優れた研究者の実験的,理論 的知見により、多少の設計指針がもてるように なってきている。近年では、特に、LED ディス プレイにおいて、幅の狭い発光の蛍光体が求 められている。LED 用蛍光体の研究が始まっ てほぼ 20 年経ったが、特性の原理の構築や 更なる新規系の創出に対する意義は未だに 終了となっておらず、興味深い分野である[15]。 最後に付言すれば、本文で述べた LSN の発 見が実際に世の中の役に立っていることから、 基礎研究の意義をあらためて感じざるを得な 10

5.謝辞

LSN の発見を含む La 系の探索研究は、著 者が三菱化学株式会社在籍中に実施した研 究であり、三菱化学に深く感謝致します。本探 索研究は、三菱化学在籍中の木島直人氏、 及び、物質・材料研究機構の広崎尚登氏(現 在フェロー)との共同研究の中で筆者がなした ものであり、謝意を表します。計算と解釈は自 宅でのものです。本文の内容とは無関係であ りますが、現所属デンカ株式会社先進技術研 究所に謝意を表します。

References

1) S. Nakamura and G. Fasol, *The blue laser diode: GaN Based Light Emitters and Lasers*, Springer, Berlin, **1997**.

 H.A. Hoppe, H. Lutz, P. Morys, W. Schnick, and A. Seilmeier, *J. Phys. Chem. Solids*, 2000, 61, 2001-2006.

3) K. Uheda, N. Hirosaki, H. Yamamoto, H.

Yamane, Y. Yamamoto, W. Inami, and K. Tsuda, *The* 206th Annual Meeting of the *Electrochemical Society* (Abstract No. 2073), Honolulu, Oct. 3, **2004**.

4) N. Kijima, T. Seto, and N. Hirosaki, *ECS*, *Trans.*, **2009**, 25, 247-252.

5) Y.Q. Li, G. de With, and H.T. Hintzen, J. *Alloys Compd.*, **2004**, 385, 1-11.

6) C. Hecht, F. Stadler, P.J. Schmidt, J.S.

Gunne, V. Baumann, and W. Schnick, *Chem. Matter.*, **2009**, 21, 1595-1601.

7) US Patent No. 6670748.

8) C.A. Morrison, J. Chem. Phys., **1980**, 72, 1001-1002.

9) B.F. Aull and H.P. Jenssen, *Phys. Rev. B*, **1986**, *34*, 6640-6646.

10) P. Dorenbos, *Phys. Rev. B*, **2000**, *62*, 15640-15649.

11) P. Dorenbos, J. Lumin., 2003, 105, 117-119.

12) T. Wang, Z. Xia, Q. Xiang, S. Qin, and Q. Liu, *J. Lumin.*, **2015**, *166*, 106-110.

13) Y. Jia, A. Miglio, S. Ponce, X. Gonze, and

M. Mikami, *Phys. Rev. B*, **2016**, *93*, 155111-1-11.

14) L.Y. Cai, X.D. Wei, H. Li, and Q.L. Liu, *J. Lumin.*, **2009**, *129*, 165-168.

15) T. Seto and T. Izawa, *ECS J. Solid State Sci. Technol.*, **2015**, 4, R83-R88.